

## ГЕРМАНИЕВЫЕ МИКРОМОДУЛЬНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ

### ТМ-4А-4 — ТМ-4Е-4 (*p-n-p*)

Конструктивное оформление — металлический герметизированный колпачок, устанавливаемый на микромодульной плате, с выводами, распаянными к пазам (см. рис. 233).

Вес 0,8 г.

Интервал рабочих температур от  $+73$  до  $-60^{\circ}\text{C}$ .

Допустимая относительная влажность окружающего воздуха 98% при температуре  $40^{\circ}\text{C}$ .

Интервал изменений атмосферного давления от 5 мм рт. ст. до 2 атм. Допускается применение транзисторов при атмосферном давлении до  $1 \cdot 10^{-6}$  мм рт. ст.

Наибольшее постоянное ускорение 150g.

Наибольшее ускорение при многократных ударах 150g.

Наибольшее допустимое ускорение при вибрациях с частотами 5—2000 гц 10g.

Микротранзисторы монтируются на микромодульных платах размером  $9,6 \times 9,6 \times 3,1$  мм и обозначаются буквами ТМ или М. Электроды транзисторов распаяются по пазам микромодульной платы: 1 — база, 5 — эмиттер, 8 — коллектор.

Рабочее положение — любое.

Основное назначение — работа в аппаратуре различного назначения с микромодульным исполнением.

Параметры транзисторов приведены в табл. 142.

Таблица 142

Параметры	Тип транзистора			
	ТМ-4А-4. ТМ-4Б-4	ТМ-4В-4	ТМ-4Г-4, ТМ-4Е-4	ТМ-4Д-4
Предельная частота усиления по току, Мгц . . . . .	60	60	120	120
Коэффициент усиления по току в схеме с общим эмиттером . .	20—300	50—600	50—600	90—600
Наибольшее напряжение на коллекторе в схеме с общей базой, в . . . . .	—15	—15	—15	—15
Наибольшая рассеиваемая мощность, мвт . . . . .	75	75	75	75